
	TK4R4P06PL,RQ
	Hersteller-Teilenummer: TK4R4P06PL,RQ Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 60V 58A DPAK Datenblätter:  TK4R4P06PL,RQ.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	TK4R4P06PL,RQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 60V 58A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	U-MOSIX-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 29A, 10V
Verlustleistung (max)	87W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	TK4R4P06PLRQDKR
Betriebstemperatur	175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3280pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 58A (Tc) 87W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58A (Tc)

TK4R4P06PL,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK4R4P06PL,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK4R4P06PL,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK4R4P06PL,RQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK4P60DA TK4P60D TOSHIBA/ TK4P60DA TK4P60D TOSHIBA/</p>	 <p>TK4Q70V,S1VQ(S) TOSHIBA TK4Q70V,S1VQ(S) TOSHIBA</p>	 <p>TK4Q60DA TOSHIBA TOSHIBA TO-251</p>	 <p>TK4P60DA(T6RSS-Q) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 3.5A DPAK-3</p>
 <p>TK4P60DB TOS TK4P60DB TOS</p>	 <p>TK4P60DB(T6RSS-Q) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 3.7A DPAK-3</p>	 <p>TK4Q60DA,Q TOSHIBA TOSHIBA TO-251</p>	 <p>TK4Q70V TOSHIBA/ TOSHIBA/ TO-251A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK4R4P06PL,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK4R4P06PL,RQ Datenblatt	TK4R4P06PL,RQ-Datenblätter	TK4R4P06PL,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK4R4P06PL,RQ
TK4R4P06PL,RQ Electronic	TK4R4P06PL,RQ-Komponenten	TK4R4P06PL,RQ-Verteiler	TK4R4P06PL,RQ-Bild	TK4R4P06PL,RQ-Teil
TK4R4P06PL,RQ Preis	TK4R4P06PL,RQ Hersteller	TK4R4P06PL,RQ Bild	TK4R4P06PL,RQ Aktie	TK4R4P06PL,RQ Inventar
TK4R4P06PL,RQ Neu	TK4R4P06PL,RQ Original	TK4R4P06PL,RQ garantiert	TK4R4P06PL,RQ RFQ	TK4R4P06PL,RQ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited